

2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1

Бескорпусные высокочастотные биполярные р-р-р транзисторы малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_T = 550$ МГц

Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{кmax} = 10$ мВт

Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэmax} = 20$ В(2Т360А-1); 15В(2Т360Б-1, 2Т360В-1)

| Тип изделия | НомерТУ | Тип корпуса | Диапазон рабочих температур |
|------------------------------------|----------------|--|-----------------------------|
| 2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1 | ЩТЗ.365.059 ТУ | Без корпуса, сопроводительная тара ТС1, ТС16 | -60°С до +85°С |

Бескорпусные кремниевые планарно-эпитаксиальные р-р-р усилительные транзисторы 2Т360А-1, 2Т360Б-1, 2Т360В-1 предназначены для использования в неремонтируемых гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках радиоэлектронной аппаратуры.

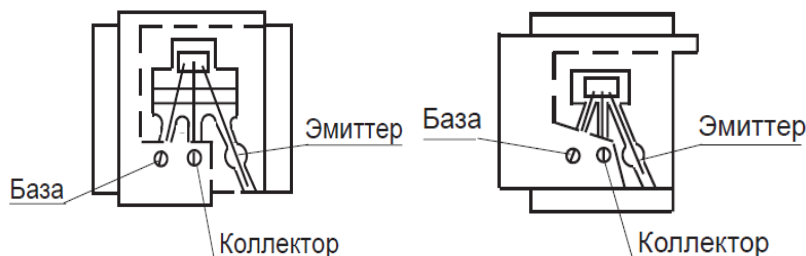
Маркировка транзисторов соответствует техническим условиям ЩТЗ.365.059 ТУ.

Знаком Н обозначаются изделия повышенной надежности.

Схема расположения выводов



Сопроводительная тара



2Т360А-1, 2Т3108Б-1, 2Т3108В-1

ТС1

ТС16

Основные электрические параметры при $T = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

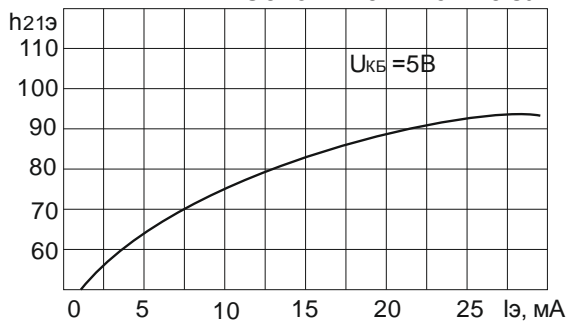
| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквен- ное обозна- чение | 2Т360А-1 | | 2Т360Б-1 | | 2Т360В-1 | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более |
| Обратный ток коллектора, мкА ($U_{кб} = 25$ В для 2Т360А-1; $U_{кб} = 20$ В для 2Т360Б-1, 2Т360В-1) | $I_{кб0}$ | | 1 | | 1 | | 1 |
| Обратный ток эмиттера, мкА ($U_{эб} = 5$ В для 2Т360А-1; $U_{эб} = 4$ В для 2Т360Б-1, 2Т360В-1) | $I_{эб0}$ | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 |
| Статический коэффициент передачи тока ($U_{кб} = 1$ В, $I_{э} = 10$ мА, $t_{и} < 2$ мс) | $h_{21э}$ | 25 | 70 | 40 | 120 | 80 | 240 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{кб} = 2$ В, $I_{э} = 5$ мА, $f = 100$ МГц) | $ h_{21э} $ | 3 | | 4 | | 4 | |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_{к} = 10$ мА, $I_{б} = 1$ мА) | $U_{кэнас}$ | | 0,35 | | 0,35 | | 0,35 |
| Напряжение насыщения база- эмиттер ($I_{к} = 10$ мА, $I_{б} = 1$ мА), В | $U_{бэнас}$ | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 |
| Постоянная времени цепи обрат- ной связи на высокой частоте, пс ($U_{кб} = 2$ В, $I_{э} = 5$ мА, $f = 5$ МГц) | $\tau_{к}$ | | 450 | | 450 | | 450 |
| Емкость коллекторного перехода ($U_{кб} = 5$ В, $f = 10$ МГц), пФ | $C_{к}$ | | 5 | | 5 | | 5 |
| Емкость эмиттерного перехода ($U_{эб} = 0$ В, $f = 10$ МГц), пФ | $C_{э}$ | | 7 | | 7 | | 7 |



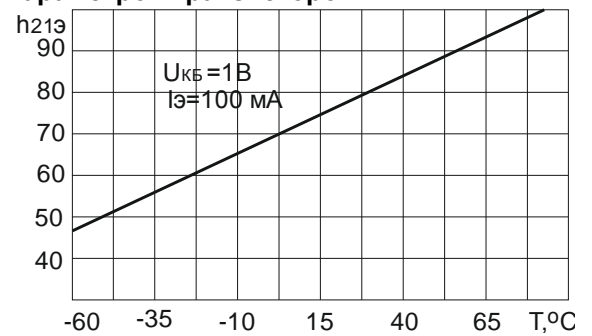
Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

| Наименование параметра, единица измерения | Буквенное обозначение | 2Т360А-1 | 2Т360Б-1 | 2Т360В-1 | Примечание |
|---|-----------------------|----------|----------|----------|------------|
| Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В | $U_{КБmax}$ | 25 | 20 | 20 | |
| Максимально – допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 10 \text{ кОм}$, В | $U_{КЭmax}$ | 20 | 15 | 15 | |
| Максимально – допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В | $U_{ЭБmax}$ | 5 | 4 | 4 | |
| Максимально – допустимый постоянный ток коллектора, мА | $I_{Кmax}$ | 20 | 20 | 20 | |
| Импульсный ток коллектора при $t_{и} \leq 1 \text{ мкс}$, $Q \geq 10$, мА | $I_{КИmax}$ | 75 | 75 | 75 | |
| Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт при $T = +55^\circ\text{C}$ при $T = +85^\circ\text{C}$ | $P_{Кmax}$ | 10 | 10 | 10 | |
| | | 5 | 5 | 5 | |
| Общее тепловое сопротивление, $^\circ\text{C}/\text{мВт}$ | $R_{Т-с}$ | 7 | 7 | 7 | |

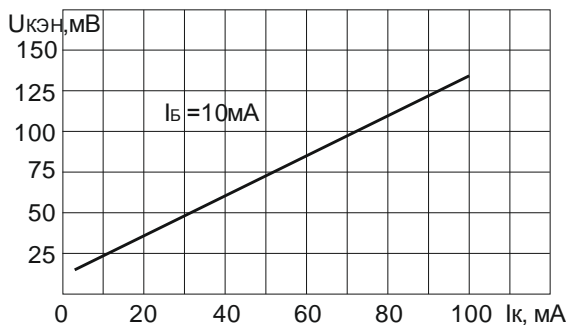
Основные типовые зависимости параметров транзисторов



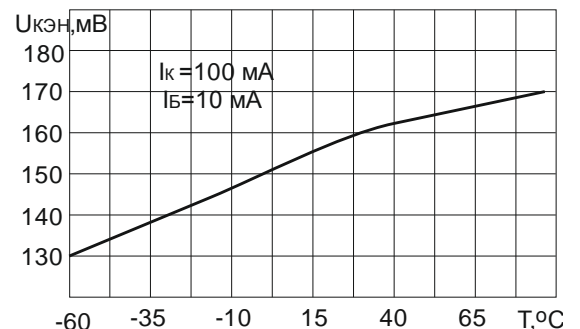
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



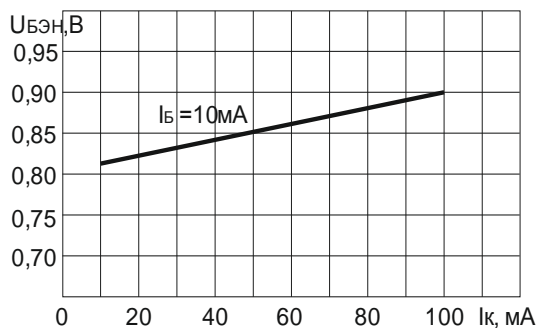
Зависимость статического коэффициента передачи тока от температуры



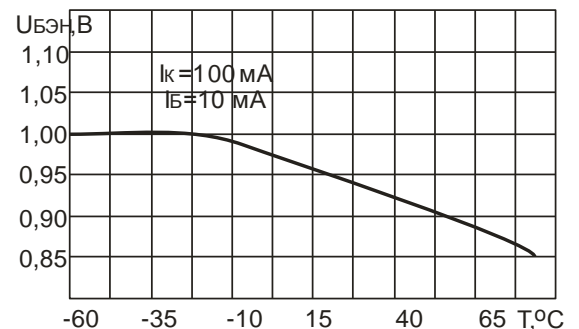
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения база-эмиттер от температуры